

## GB/T 2900.66-2004

GB/T 2900.66-2004

IEC 60050-521 2002

IEC 60050-521 2002

GB/T 2900 66

521

GB/T 2900





## 前 言

GB/T 2900 的本部分等同采用 IEC 60050-521:2002《国际电工词汇 第 521 部分:半导体器件和集成电路》。

本部分等同翻译 IEC 60050-521:2002。

为了便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

“本国际标准”一词改为“本部分”;

删除国际标准的前言和说明。

本标准中术语编号与 IEC 60050-808:2002 保持一致。

本标准由全国电工术语标准化技术委员会提出。

本标准由全国电工术语标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所(CESI)、机械科学研究院。

本标准主要起草人:赵英、顾振球、杨英、罗发明、刘春勋、陈裕焜。















































































































<b>W</b>		Zener voltage ..... 521-05-10
<b>wafer</b>		<b>zero</b>
wafer ..... 521-05-29		residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) ..... 521-09-14
<b>write</b>		residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) ..... 521-09-15
dynamic (read/write) memory ..... 521-11-10		<b>zone</b>
read/write memory ..... 521-11-07		growing by zone melting (of a single crystal) ..... 521-03-02
static (read/write) memory ..... 521-11-09		impurity concentration transition zone ... 521-02-67
<b>Z</b>		zone levelling ..... 521-03-04
<b>Zener</b>		zone refining ..... 521-03-03
Zener breakdown (of a PN junction) ... 521-05-09		